

# Bibliographie

- [1] F. Lémery, “modélisation comportementale des circuits analogiques et mixtes”, *thèse de doctorat, Institut national polytechnique de Grenoble, 20 décembre 1995.*
- [2] A.-M. Trullemans-Anckaert, “méthodologie de validation de systèmes mixtes, en environnement réaliste”, *Actes du colloque international sur techniques et technologies fondamentales de la nouvelle économie'2002 (TTFNE'2002), Albena, Bulgarie, 15-18 sept, pp 197-202. 2002.*
- [3] S. Jemmali, “contribution à l’élaboration de méthodologies et d’outils d’aide à la conception de Systèmes multi-technologiques”, *Thèse de doctorat, école nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, novembre 2003.*
- [4] O. Alali, “modélisation VHDL-AMS analogique et simulation SPICE”, *thèse de doctorat, école nationale supérieure des télécommunications de Paris, novembre 1998*
- [5] S. Jemmali, " contribution a l'élaboration de méthodologies et d'outils d'aide a la conception de système multi technologiques", thèse de doctorat, école nationale supérieure des communications, 2003, PARIS
- [6] Y. Hervé, “VHDL-AMS applications et enjeux industriels”, *cours et exercices corrigés 2eme et 3eme cycles écoles d'ingénieurs de paris, 2002.*
- [7] A. Vachoux, “modélisation de systèmes analogiques et mixte introduction a VHDLAMS”, *notes de cours à option 2ème cycle, école polytechnique fédérale de Lausanne, été 2003.*
- [8] [www-ensps.u-strasbg.fr/coursen/option3A/vhdlamsb.htm](http://www-ensps.u-strasbg.fr/coursen/option3A/vhdlamsb.htm)
- [9] Their IBRAHIM « contribution au développement de modèles pour l'électronique de puissance en VHDL-AMS » thèse de doctorat à l'INSA de lyon 2009
- [10] Y. Kebbaty, “développement d’une méthodologie de conception matériel à base de modules génériques VHDL/VHDL-AMS en vue d’une intégration de systèmes de commande électriques”, *thèse de doctorat, école doctorale sciences pour l'ingénieur, université Luis pasteur Strasbourg, décembre 2002.*
- [11] H. Shichman, D.A. Hodges, “modeling and simulation of insulated-gate field-effect transistor switching circuits”, *IEEE journal solid-state circuits, volume: 3 issue: 3 , Sep 1968, page(s):285 . 289.*
- [12] D. P. Foty, “MOSFET modeling with SPICE, principe and practice”, *653 pages, practice hall PTR, new jersey, USA, 1997*
- [13] S. Latreche, “le transistor métal-oxide-semi-conducteur a canal vertical en régime non linéaire d’amplification haute fréquence de puissance”, *thèse de doctorat 3ème cycle, université*

de Paul Sabatier Toulouse, 1985.

[14] K. Kassmi, “transistor vdmos pour amplification de puissance en bande UHF”, *thèse de doctorat, université Paul Sabatier de Toulouse*, 1993.

[15] B. J. BALIGA, M. S. ADLER, R. P. LOVE, P. V. GRAY, and M. D. ZOMMER “the insulated gate transistor, a new three-terminal- MOS-controlled bipolar power device”, *IEEE trans. electron devices*, vol. ED-31, pp. 821-828, 1984.

[16] J. P. RUSSEL and al. “The COMFET- A New High conductance MOS gated device”, *IEEE electron device lett*, vol EDL-4, pp. 63-65, Mar. 1983.

[17] R. Neale, “the latest IGBTs set to seriously damage the health of GTOs”, *electronic engineering*; pp 31-34; december 1995.

[18] H. Yilmaz, K. Omyang, M. Chang, J. Benjamin and R. Van Dell “recent advances in insulated gate bipolar transistor technology”, *IEEE Trans on industry application*, vol 26 No5, pp831-834, Sep/Oct1990.

[19] J.P Charte “éléments de physique sur le composant de puissance IGBT”, *séminaire technique SEE sur le composant IGBT*, 22 sept 1989.

[20] B. K. BOSE “evaluation of modern power semi-conducteur devices and future trends of converters”, *IEEE trans on industry application*, Vol 28 n° 2, pp 403-414, march/april 1992,

[21] O. Elmazria, “caractérisation et simulation de l'IGBT dans le but d'optimiser ses performances au moyen d'irradiation par electrons ”, *thèse de doctorat, école doctorale: promen, université de metz et supelec, académie de nancy-metz*, 15 novembre 1996.

[22] Y. A. Chapuis, “contrôle directe du couple d'une machine asynchrone par l'orientation de son flux statorique”, *thèse de doctorat, institut national polytechnique de Grenoble*, Janvier 1996

